



BA 243 · BA 244

Silizium-Planar-Dioden Silicon planar diodes

Anwendungen: Bereichsumschaltung in VHF-Tunern

Applications: Band selector in VHF-tuners

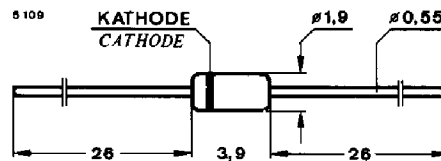
Besondere Merkmale:

- Niedriger differentieller Durchlaßwiderstand im VHF-Bereich
- Kleine Diodenkapazität

Features:

- Low differential forward resistance in VHF-range
- Low diode capacitance

**Abmessungen in mm
Dimensions in mm**



Normgehäuse
Case
54 A 2 DIN 41 880
JEDEC DO 35
Gewicht · Weight
max. 0,15 g

**Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings**

Sperrspannung <i>Reverse voltage</i>	U_R	20	V
Durchlaßstrom <i>Forward current</i>	I_F	100	mA
Sperrschichttemperatur <i>Junction temperature</i>	t_j	150	°C
Lagerungstemperaturbereich <i>Storage temperature range</i>	t_{stg}	-55...+150	°C

**Wärmewiderstand
Thermal resistance**

		Min.	Typ.	Max.
Sperrschicht-Umgebung <i>Junction ambient</i>	R_{thJA}			350 °C/W

BA 243 · BA 244

Kenngrößen Characteristics

		Min.	Typ.	Max.	
$t_j = 25^\circ\text{C}$,					
Durchlaßspannung Forward voltage $I_F = 100\text{ mA}$	U_F			1	V
Sperrstrom Reverse current $U_R = 15\text{ V}$	I_R			100	nA
Diodenkapazität Diode capacitance $U_R = 15\text{ V}, f = 100\text{ MHz}$	C_D		1,3	2	pF
Serieninduktivität Series inductance	L_S		2,5		nH
Differentieller Durchlaßwiderstand Differential forward resistance $I_F = 10\text{ mA}, f = 200\text{ MHz}$					
	BA 243		0,7	1	Ω
	BA 244		0,4	0,5	Ω